

三菱半導体(トランジスタ)
2SA1369

小形モータ、プランジャドライブ用
シリコンPNPエピタキシャル形

概要

2SA1369は、樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャル形トランジスタで、コレクタ損失およびコレクタ電流が大きく、さらに h_{FE} が高く、設計、製造されていますので、VTR、テープデッキ、プレーヤ等の小形モータのドライブや、メカコントロール系(プランジャ、リレー等のドライブ)、電源用として最適です。またコレクタフィンが外部に出ており、基板に直接半田付することによりコレクタの許容損失が向上します。

2SC3439とコンプリメンタリです。

特長

- 小形外形のためセットの小形化、高密度実装が可能
- h_{FE} が高い ($h_{FE}=400\sim 800$)
- コレクタ電流が大きい ($I_C=-1.5A$ 、 $I_{CM}=-3A$)
- コレクタ・エミッタ飽和電圧が小さい
 $V_{CE(sat)}=-0.25V$ 標準 (@ $I_C=-1A$ / $I_B=-20mA$)
- コレクタ損失が大きい ($P_C=500mW$)

用途

VTR、テープデッキ、プレーヤ等の小形モータドライブ、リレー等のドライブや、リップフィルタ等の電源用

最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

記号	項目	定格値	単位
V_{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	-30	V
V_{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	-6	V
V_{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	-20	V
I_C	コレクタ電流	-1.5	A
I_{CM}	せん頭コレクタ電流	-3	A
P_C	コレクタ損失 ($T_a=25^\circ C$)	500	mW
T_j	接合部温度	+150	$^\circ C$
T_{stg}	保存温度	-55~+150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

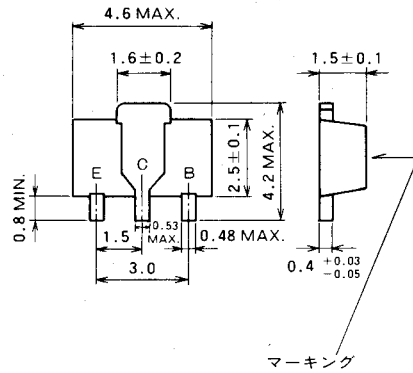
記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CB0}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C=-10\mu A$, $I_E=0$	-30			V
$V_{(BR)EB0}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E=-10\mu A$, $I_C=0$	-6			V
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C=-1mA$, $R_{BE}=\infty$	-20			V
I_{CB0}	コレクタしゃ断電流	$V_{CB}=-20V$, $I_E=0$			-0.1	μA
I_{EB0}	エミッタしゃ断電流	$V_{EB}=-2V$, $I_C=0$			-0.1	μA
h_{FE} †	直流電流増幅率	$V_{CE}=-6V$, $I_C=-500mA$	400		800	-
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C=-1A$, $I_B=-20mA$		-0.25	-0.5	V
f_T	利得帯域幅積	$V_{CE}=-10V$, $I_E=10mA$		90		MHz
C_{ob}	コレクタ出力容量	$V_{CB}=-10V$, $I_E=0$, $f=1MHz$		37		pF

†: h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

マーキング	GG
h_{FE}	400~800

外形図

単位: mm



電極接続

E: エミッタ
C: コレクタ
B: ベース
(SOT-89)

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。

マーク図

